

J685 U.S. PRO
00/01/18

EVENSON, McKEOWN, EDWARDS & LENAHAN, P.L.L.C.
1200 G Street, N.W., Suite 700
Washington, D.C. 20005
(202) 628-8800

January 18, 2000

JC511 U.S. PRO
09/484421
01/18/00

Box PATENT APPLICATION

Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Re: New U.S. Patent Application
Our Ref: 622/48561

Sir:

Transmitted herewith for filing is the patent application of:

Martin Dubs et al.

entitled: SPUTTER CHAMBER AS WELL AS VACUUM TRANSPORT CHAMBER
AND VACUUM HANDLING APPARATUS WITH SUCH CHAMBERS

Enclosed are:

1. German Specification, including 34 claims (28 pages).
2. 9 Sheets of _____ Formal xx Informal drawings
showing Figs. 1 - 10
3. X Declaration and Power of Attorney (**unexecuted**).

The filing fee is being deferred.

Respectfully submitted,


Donald D. Evenson
Donald D. Evenson
Registration No. 26,160

DDE:rcs

Sputterkammer sowie Vakuumtransportkammer und Vakuumbehandlungsanlagen mit solchen Kammern

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sputterkammer mit mindestens einer Sputterquelle mit zu einer Zentralachse mindestens genähert symmetrischer Sputterneufläche, weiter mit einem Substratträger, der getrieben um eine Substratträgerachse drehbar ist, wobei Zentralachse und Substratträgerachse zueinander schief stehen, dies gemäss Oberbegriff von Anspruch 1.

10 Im weiteren betrifft die vorliegende Erfindung eine Vakuumbehandlungsanlage mit einer derartigen Sputterkammer nach dem Oberbegriff von Anspruch 16, eine Vakuumtransportkammer für scheibenförmige Werkstücke nach demjenigen von Anspruch 17 und schliesslich eine Vakuumbehandlungsanlage mit einer derartigen 15 Vakuumtransportkammer nach dem Oberbegriff von Anspruch 29.

Aus der US 4 818 561 sowie der US 4 664 935 sind Sputterkammern der eingangs genannten Art bekannt. Die Zentralachse der Sputterquelle ist bezüglich einer Rotationsachse eines Substratträgers schiefwinklig angeordnet. Der Substratträger wird um die 20 Substratträgerachse getrieben in Rotation versetzt. Mit dieser Sputterkammer werden Beschichtungsgleichförmigkeiten von besser als $\pm 4\%$ an Wafers erreicht, deren Durchmesser bis 200 mm betragen können.

Sowohl bei der Fertigung von Speicherscheiben, dabei insbesondere von optischen Speicherscheiben, wie von Mini Disks oder CDs, weiter bei der Fertigung von Mastern, aber auch für die Herstellung piezoelektrischer Wafer, von Wafers für die Halbleiterfertigung, dabei speziell auch für Wafer für die Imple-

mentierung von SAW (Surface Acoustic Waves) ist es von hoher Wichtigkeit, eine gleichförmige Schichtdickenverteilung zu erreichen, die mindestens gleich gut, wenn nicht besser ist als die mit den vorbeschriebenen Sputterkammern erreichbare. Hinzu 5 sollten die Beschichtungsraten möglichst hoch sein, um möglichst kurze Beschichtungszeiten und damit möglichst hohe Produktionsraten zu erzielen.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Sputterkammer eingangs genannter Art vorzuschlagen, mittels welcher bei erhöhten Beschichtungsraten Schichtdickenhomogenitäten gar besser 10 als mit den vorbekannten Sputterkammern erreichbar sind.

Dies wird durch Realisation der erfindungsgemäßen Sputterkammer nach dem Kennzeichen von Anspruch 1 erreicht, nämlich dadurch, dass die Sputterquelle eine Magnetronsputterquelle ist.

15 Während bei einer üblichen Sputterquelle die Sputterfläche des Targets im wesentlichen gleichmäßig abgetragen wird, verhält sich dies bei Magnetronsputterquellen völlig anders. Aufgrund des den Magnetronsputterquellen eigenen, über der Sputterfläche des Targets aufgebauten, in sich geschlossen tunnelförmigen Ma-
20 gnetfeldes ergibt sich auf der Sputterfläche ein umlaufender Erosionsgraben, welcher mit zunehmender Abstäubungszeit die Richtungscharakteristik des abgestäubten Targetmaterials variiert. Sind mehrere Tunnelfelder vorgesehen, ergeben sich gegebenenfalls umlaufende Erosionsgraben.

25 Wohl ergeben Magnetronsputterquellen höhere Abstäubungs- und damit auch Beschichtungsraten als übliche Sputterquellen, sind aber bezüglich der erzielbaren Gleichförmigkeit der Schichtdicken wesentlich kritischer. Um so erstaunlicher ist es, dass durch erfindungsgemäßen Einsatz einer Magnetronsputterquelle

an der erfindungsgemässen Sputterkammer nicht nur eine höhere Beschichtungsrate erzielbar ist und damit kürzere Beschichtungszeiten, sondern auch, hinzukommend, Beschichtungsdicken-Gleichförmigkeiten erzielt werden, die mindestens so gut, ja 5 gar wesentlich besser sind, als dies mit den eingangs erwähnten Sputterkammern gemäss den erwähnten Schriften offenbar erzielbar ist.

Bevorzugte Ausführungsvarianten der erfindungsgemässen Sputterkammern sind in den Ansprüchen 2 bis 15 spezifiziert.

10 Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die ob-genannte erfindungsgemässe Sputterkammer so in eine Vakuumbe-handlungsanlage einzubinden, dass damit automatisiert die schnellen Beschichtungszeiten, welche mit der erfindungsgemä-ssen Sputterkammer erreichbar sind, auch vollumfänglich genutzt 15 werden können. Dies wird mittels der Vakuumbehandlungsanlage nach Anspruch 16 erreicht, d.h. dadurch, dass die erwähnte Sputterkammer über eine oder mehrere Transportkammern mit mindestens einer Schleusenkammer verbunden ist, woran Substrate von der Umgebung in Vakuum ein- bzw. vom Vakuum in die Umgebung 20 ausgeschleust werden.

Im weiteren wird, dem Wortlaut von Anspruch 17 folgend, eine insbesondere für kurze Transportzyklen konzipierte, an sich er-finderische Vakuumtransportkammer vorgeschlagen, welche sich dem Wortlaut von Anspruch 29 bzw. 30 folgend ideal mit der er-25 findungsgemässen Sputterkammer kombinieren lässt zu einer Vaku-umbehandlungsanlage mit äusserst kurzen Transportzyklen, wei-ter, insbesondere in bevorzugten Ausführungsformen der erfin-dungsgemässen Transportkammer, zu äusserst kurzen Ein- bzw.

Ausschleuszyklen von zu beschichtenden bzw. beschichteten Substraten führt.

Bevorzugte Ausführungsformen der auch für sich betrachtet erfindungsgemässen Vakuumtransportkammer sind in den Ansprüchen 5 18 bis 28 spezifiziert, der erfindungsgemässen Vakuumbehandlungsanlage mit einer derartigen Transportkammer in den Ansprüchen 29 bis 32.

Im weiteren bezieht sich die vorliegende Erfindung auf ein Verfahren zur Herstellung beschichteter Datenspeicherscheiben oder 10 von Wafern nach dem Wortlaut von Anspruch 34.

Die erfindungsgemässe Sputterkammer, Transportkammer sowie die erfindungsgemässen Anlagen eignen sich insbesondere für die Beschichtung optischer Datenspeichersubstrate, weiter von Mastern für die Fertigung derartiger optischer Datenspeicherscheiben 15 oder von piezoelektrischen Wafern oder Wafern für die Halbleiterfertigung.

Die Erfindung wird anschliessend beispielsweise anhand von Figuren erläutert. Es zeigen:

Fig. 1: schematisch, eine erfindungsgemässe Sputterkammer;

20 Fig. 2: die Aufsicht auf eine Substratträgeranordnung, wie sie an der erfindungsgemässen Sputterkammer nach Fig. 1 vorgesehen ist, zur Definition der Verhältnisse bezüglich darauf abgelegter Substrate;

25 Fig. 3: schematisch, die Anordnung von Substratträger und Magnetrönsputtertarget an einer erfindungsgemässen Sputterkammer zur Definition der gegenseitigen geometrischen Lageverhältnisse;

5 Fig. 4: in einer Darstellung analog zu Fig. 1, eine erfindungsgemäße Sputterkammer mit Doppelmagnetronquelle;

Fig. 5: wiederum schematisch, eine weitere bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Sputterkammer, bei der ein Prozessraum abgetrennt wird;

Fig. 6: schematisch, in Seitenansicht und teilweise gebrochen, eine erfindungsgemäße Vakuumbehandlungsanlage mit einer erfindungsgemäßen Sputterkammer in einer Ausführungsvariante;

10 Fig. 7: eine Aufsicht auf eine prinzipiell wie die Anlage nach Fig. 6 aufgebaute erfindungsgemäße Vakuumbehandlungsanlage mit mehreren Behandlungsstationen und einer Ein-/Austrittsschleuse;

15 Fig. 8: teilweise vereinfacht, eine erfindungsgemäße Transportkammer, kombiniert mit einer erfindungsgemäßen Sputterkammer zur Bildung einer erfindungsgemäßen Vakuumbehandlungsanlage bevorzugter Bauform;

Fig. 9: eine Aufsicht auf die Transportkammer nach Fig. 8, entsprechend der Schnittlinie II-II von Fig. 8, und

20 Fig. 10: über dem Substratradius abgetragene Schichtdicken als Resultat beschriebener Beschichtungsversuche.

In Fig. 1 ist schematisch eine erfindungsgemäße Sputterkammer dargestellt. Sie umfasst eine Magnetronputterquelle 1. Über der Sputterfläche 3 einer (nicht dargestellten) Targetanordnung 25 der Magnetronputterquelle 1 ist schematisch das um die Zentralachse Z der Quelle 1 in sich geschlossene, umlaufende, tunnelförmige Magnetronmagnetfeld H dargestellt. In Aufsicht, d.h.

in Richtung der Zentralachse Z betrachtet, kann die Sputterfläche 3 der Magnetronquelle 1 rechteckig, quadratisch, elliptisch etc. ausgebildet sein, ist aber bevorzugterweise bezüglich der Zentralachse Z rotationssymmetrisch. Jedenfalls liegt aber die

5 Zentralachse Z in einer Symmetrieebene der in Aufsicht betrachteten Sputterfläche 3. Im weiteren kann die Sputterfläche, in ihrem Neuzustand als Sputterneufläche bezeichnet, wenigstens im wesentlich plan sein oder eine konkave Fläche definieren. Es kann ein einziges um die Zentralachse Z umlaufendes, tunnelförmiges, 10 in sich geschlossenes Magnetfeld H vorgesehen sein, zwei oder mehr.

Das eine oder die mehreren vorgesehenen, um die Zentralachse Z in sich geschlossen umlaufenden Magnetfelder H können weiter zeitlich stationär oder zeitlich variierend ausgebildet sein, 15 wie durch Vorsehen bewegter Magnetenordnungen unterhalb der Targetanordnung mit Permanent- und/oder Elektromagneten bzw. erzeugt durch zeitlich selektiv angesteuerte Elektromagnete.

Zurückkommend auf Fig. 1 weist die erfundungsgemäße Sputterkammer einen Substratträger 5 auf, welcher getrieben - 6 - um 20 eine Substratträgerachse A drehbeweglich ist. Der Substratträger 5 ist so ausgebildet, dass er ein Einzelsubstrat 7, bevorzugt zur Substratträgerachse A zentriert, oder, bevorzugt ebenso zentriert, mehrere Substrate 7a aufnehmen kann, Fig. 2. Dabei kann das eine Substrat 7 oder auch die mehreren 7a den 25 Substratträger 5 durchaus und wie in Fig. 2 bei 7' bzw. 7a' dargestellt überlappen.

Wird im Folgenden vom Durchmesser ϕ_s gesprochen, so bedeutet diese Grösse

sen die beiden bevorzugterweise einen Winkel β ein, für den gilt:

$$30^\circ \leq \beta \leq 60^\circ,$$

dabei bevorzugt

5 $40^\circ \leq \beta \leq 55^\circ,$

insbesondere bevorzugt

$$43^\circ \leq \beta \leq 50^\circ,$$

dabei ganz besonders bevorzugt einen Winkel $\beta \approx 45^\circ$.

Mit genauer Einhaltung dieses Winkels β wird die Gleichförmigkeit der Dicke der abgelegten Schicht optimiert.

10 Wie in Fig. 3 schematisch dargestellt, liegt der Ort L geringsten Abstandes von Zentralachse Z und Substratträgerachse A bevorzugt mindestens genähert auf dem Zentrum des Substratträgers 5, dabei weiter bevorzugt auf der zu beschichtenden Oberfläche eines - zentrierten - Substrates 7, 7'.

15 Die erfindungsgemäße Sputterquelle kann im Raum beliebig orientiert angeordnet werden.

20 Wie sich aus Fig. 3 weiter ergibt, ist die Projektion der Substratfläche auf eine Ebene E_z senkrecht zur Zentralachse Z vorzugsweise kleiner als die Projektion der Sputterneufläche auf diese Ebene E_z .

In Fig. 3 ist weiter qualitativ der sich im Betrieb auf der Sputterfläche ausbildende, um die Zentralachse Z umlaufende Erosionsgraben 15 dargestellt bzw. eines zweiten 15a, wenn zwei

umlaufende, in sich geschlossene, tunnelförmige Magnetfelder realisiert werden.

Es bezeichnet r_{tr} bezüglich der Zentralachse Z den Radius des Ortes grösster Erosionstiefe des radial äussersten Erosionsgrabs 5 bens 15.

In einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemässen Sputterkammer ergibt sich zwischen diesem Radius r_{tr} und dem Abstand D zwischen Sputterneufläche und dem Ort L bzw. zwischen Sputterneufläche und Substratträger 5

10 $1/4 \leq r_{tr} / D \leq 2/3.$

Im weiteren gilt gemäss Fig. 3 für den Durchmesser ϕ_r der Projektion einer rotationssymmetrischen Sputterneufläche auf die Ebene E_z und besagtem Abstand D bevorzugterweise

15 $3/4 \leq \phi_r / D \leq 2,$

dabei insbesondere, dass gilt

$$\phi_r \approx 1,2 D.$$

Bezüglich des Durchmessers ϕ_s (siehe Definition oben) gilt mit Bezug auf den erwähnten Abstand D, bevorzugterweise

$$\phi_s / D \leq 1,8.$$

20 Im weiteren gilt in bevorzugter Ausführungsform bezüglich des erwähnten Durchmessers ϕ_s und des erwähnten Sputterflächen- bzw. Sputterflächenprojektions-Durchmessers ϕ_r bevorzugterweise

$$0,5 \leq \phi_s / \phi_r \leq 2,4,$$

bevorzugterweise

$$1 \leq \phi_s / \phi_r \leq 2,4.$$

Insbesondere bei sich mindestens genähert wie in Fig. 3 dargestellt schneidenden Achsen Z und A ergeben die angegebenen Dimensionierungsvorschriften eine optimale Ausnützung des vom Target 4 abgesputterten zu dem auf das oder die Substrate abgelegten Material, nämlich von mindestens 10 %. Dabei sind Schichtdickenabweichungen entlang der beschichteten Substratflächen von höchstens $\pm 1\%$ erreichbar, ohne dass dabei, insbesondere an einem planen Rundtarget, bezüglich der Ausbildung der Erosionsgräben besondere Vorkehrungen getroffen werden müssten.

Die erwähnten Dimensionierungsvorschriften führen zusätzlich zu folgenden Vorteilen:

- minimale Empfindlichkeit der resultierenden Gleichförmigkeit der Schichtdicken auf Variationen von D und somit auch auf die zunehmende Erosion des Targets im Laufe seiner Lebensdauer;
- minimale Empfindlichkeit der Gleichförmigkeit der Schichtdicken auf Änderungen des oder der Erosionsprofile;
- minimale Empfindlichkeit der Gleichförmigkeit der Schichtdicken auf Positionierungsfehler des oder der Substrate am Substratträger 5.

In besonders bevorzugter Ausführungsform gilt:

$$50 \text{ mm} \leq \phi_s \leq 400 \text{ mm},$$

dabei bevorzugterweise

$$50 \text{ mm} \leq \phi_s \leq 300 \text{ mm},$$

dabei insbesondere bevorzugt und insbesondere für Einzelsubstrate zentriert zur Substratträgerachse A, Durchmesser ϕ_s von 64 mm (insbesondere für Mini Disks), 120 mm (insbesondere für CDs), 160 bis 240 mm (für CD Master) eingesetzt. Für das hochgenaue Ablegen von Schichten auf piezoelektrischen Wafern wird die Substrathalterung bevorzugterweise für Substratdurchmesser von mindestens 75 mm ausgelegt, für die Behandlung von Wafern für die Halbleiterfertigung für die Aufnahme von Wafern mit Durchmessern zwischen 150 und 300 mm.

Wie in Fig. 4 schematisch dargestellt, können zwei oder mehr Quellen 10a, 10b, wovon mindestens eine eine Magnetronquelle ist, gleichzeitig oder abwechselnd auf denselben Substratträger 5 bzw. die darauf plazierten Substrate wirken. Dadurch wird es möglich, beispielsweise Legierungen unter Einhalt der eingangs erwähnten Anforderungen abzulegen oder weitere Verbindungen unter Einbezug der Möglichkeit, auch reaktiv zu sputtern. Durch genaue Positionierung des Substratträgers 5 in der Z- und X-Richtung lassen sich dabei die quellspezifischen Beschichtungseigenschaften einstellen.

In Fig. 5 ist wiederum schematisch eine weitere bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemässen Sputterquelle dargestellt. Die Magnetronquelle 1 und der Substratträger 5 bzw. darauf abgelegte Substrate schliessen, in Bearbeitungsposition, einen Prozessraum PR ab, indem sich Substratträger 5 oder ein Substrat selber soweit an Seitenwände 22 der Vakuumkammer anschmiegen, dass die freie Drehbewegung ω noch gewährleistet ist. Hierzu kann, wie in Fig. 5 dargestellt, der Substratträger

5 nicht nur getrieben in die erwähnte Rotationsbewegung ω ver-
setzt, sondern bevorzugt auch linear in Bearbeitungsposition
angehoben bzw. von ihr abgesenkt werden. Durch Abkopplung des
Prozessraumes P von übrigen Kammerpartien, insbesondere mit be-
wegten Teilen, wird die Partikelkontamination während des Be-
schichtens reduziert.

In Fig. 6 ist schematisch eine erste Ausführungsvariante einer
erfindungsgemässen Vakuumbehandlungsanlage mit mindestens einer
erfindungsgemässen Sputterkammer 20 dargestellt. Die Sputter-
kammer 20 mit der Magnetronquelle 21, welche zu Wartungszwecken
bzw. Targetwechsel wie gestrichelt dargestellt aufklappbar ist,
ist an einer Transportkammer 23 angeflanscht. In der Transport-
kammer 23 wirkt eine Transporteinrichtung 27, welche um eine
Drehachse B mittels eines Antriebes 25 drehbeweglich ist. Es
ragen von der Drehachse B ein, zwei oder mehr (siehe Fig. 10)
Transportarme 29 mit mindestens einer bezüglich der Achse B ra-
dialen Komponente nach aussen und tragen je Substratträger 31.
Die Substratträger 31 können - wie mit dem Doppelpfeil F darge-
stellt - getrieben ausgefahren, insbesondere in Bearbeitungspos-
ition gebracht werden bzw. rückgeholt werden, und weiter - wie
vorerläutert wurde - um die Achse A der Substratträger 31 ge-
trieben rotiert werden.

In Fig. 7 ist in Aufsicht eine Anlage analog zu derjenigen von
Fig. 6 mit mehreren Behandlungsstationen dargestellt, wovon
25 mindestens eine eine erfindungsgemässe Sputterkammer ist.

An der Transportkammer 29 direkt oder via weitere Transportkam-
mern ist mindestens eine Schleusenkammer 33 vorgesehen, mittels
welcher die zu behandelnden Substrate von der Umgebungsatmo-
sphäre in Vakuum eingeschleust bzw. vom Vakuum in die Umge-

bungsatmosphäre ausgeschleust werden. Ab Einschleusen werden die Substrate durch eine oder mehrere Transporteinrichtungen, gegebenenfalls nach Durchlaufen weiterer Behandlungsschritte, an eine erfindungsgemäße Sputterbeschichtungsstation - wie der 5 Station 21 von Fig. 6 - zugeführt.

In Fig. 8 ist, einerseits, eine an sich erfindungsgemäße Transportkammer dargestellt, kombiniert mit einer erfindungsgemäßen Magnetronputterkammer vorerläuterter Art, damit, anderseits eine erfindungsgemäße Anlage bildend.

Fig. 9 zeigt dabei eine Schnittdarstellung gemäß Linie II-II durch die Anordnung nach Fig. 8. Die Kombination der noch zu beschreibenden Transportkammer und Schleusenkammer mit der erfindungsgemäßen, vorbeschriebenen Magnetronputterkammer ergibt eine höchst kompakte Anlagenkonfiguration mit kurzen Schleus- und Transportzyklen und - aufgrund der erfindungsgemäßen Sputterkammern - ebenso kurzen Beschichtungszyklen.

Die erfindungsgemäße Vakuumtransportkammer 41 weist einen Innenraum 43 auf, welcher einerseits durch eine Grundplatte 45 begrenzt ist, andererseits durch eine Seitenwandstruktur 47 sowie eine der Grundplatte 45 gegenüberliegende Abdeckungsstruktur 49. Die Innenfläche der Abdeckungsstruktur 49 kann dabei vorzugsweise von der Innenfläche der Grundplatte 45 mit einem Abstand d beabstandet sein, welcher bevorzugterweise höchstens gleich ist wie die Dicke D der Grundplatte 45, vorzugsweise und 20 wie dargestellt gar wesentlich geringer.

In der Abdeckungsstruktur 49 der erfindungsgemäßen Transportkammer sind Werkstückdurchreiche-Öffnungen 51 vorgesehen, an der in den Figuren 8 und 9 dargestellten, bevorzugten Ausfüh-

rungsform deren zwei. Es können selbstverständlich auch mehr als zwei der erwähnten Öffnungen 51 vorgesehen sein.

In der erfindungsgemäßen Transportkammer wirkt eine Transporteinrichtung 57, deren bevorzugter Aufbau insbesondere aus Fig.

5 9 ersichtlich ist. Seitlich an die Grundplatte 45 bzw. an der Seitenwandstruktur 47 angeflanscht ist ein Drehachsengehäuse 53 vorgesehen, worin die Antriebsdrehachse 55 der Transporteinrichtung 57 gelagert ist. Die senkrecht zur Innenfläche der Grundplatte 45 ausgerichtete Drehachse 55 trägt in der dargestellten, bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Transportkammer, als Transporteinrichtung 57, eine Transportkelle 59 mit Stiel 60 und einer tellerartigen Werkstückaufnahme 61. Die Transportkelle 59 wird, wie in Fig. 9 dargestellt, von einer ersten Schwenkposition, in der die Werkstückaufnahme 61 mit der einen der beiden Öffnungen 51 ausgerichtet ist, in die gestrichelt dargestellte zweite Position geschwenkt, in welcher die Werkstückaufnahme 61 auf die zweite der erwähnten Öffnungen 51 ausgerichtet ist. Wie ersichtlich, ist die Drehachse 55 der Transporteinrichtung 57 bezüglich einer Verbindungsline der in 10 Fig. 9 eingetragenen Öffnungszentralachse Z_{S1} versetzt angeordnet. Im weiteren liegen die Öffnungen 51 an der erfindungsgemäßen Transportkammer so nahe beieinander, dass - wie sich insbesondere aus Fig. 8 ergibt - dazwischen nur gerade genügend Platz ist, um, wie noch zu erläutern sein wird, eine Bearbeitungsstation an der einen der beiden Öffnungen anzuflanschen 15 bzw. anzuordnen.

20

25

Durch die erwähnte Lage der Drehachse 55 sowie die Minimalisierung des Öffnungzwischenraumes A (Fig. 9) werden optimal kurze Transportwege für die Transporteinrichtung 57 realisiert, mit

Schwenkwinkeln φ von höchstens 120° , bevorzugt von höchstens 90° .

In der bevorzugten dargestellten Ausführungsform ist an der einen Öffnung 51 eine Schleusenkammer integriert. Die eine Öffnung, 51a, ist mit einem Deckel 65 versehen, welcher, wie aus Fig. 8 ersichtlich, motorisch getrieben um eine Schwenkachse 67 schwenkbar ist. Diese Achse ist bevorzugterweise zwischen den Öffnungen 51 gelegen. Der Deckel 65 dichtet mit Dichtungen 69 gegen äussere Umrandungspartien der Öffnung 51a an der Abdeckungsstruktur 49, welche Dichtungen 69 in geschlossenem Zustand ggf. von dem noch zu beschreibenden linearen motorischen Deckelantrieb verspannt werden.

In Fig. 8 ist die Werkstückaufnahme 61 sowohl in Ausrichtung mit der Öffnung 51a wie auch in Ausrichtung mit der weiteren Öffnung 51, 51b dargestellt. Im Bereich der Öffnung 51a ist an der inneren Öffnungsumrandungsfläche der Abdeckungsstruktur 49 eine Dichtungsanordnung vorgesehen, bevorzugt in Form einer hydraulisch, vorzugsweise aber einer pneumatisch betätigbaren, expandierbaren Dichtung 71, welche über einen Anschlussstutzen 73 druckmediumbeaufschlagt wird. Durch Druckbeaufschlagung der expandierbaren Dichtung 71 wird diese dichtend an den Umrandungsbereich der Werkstückaufnahme 61 gepresst. Um diese peripherie Dichtungsbelastung verzugsfrei aufzunehmen, ist die Werkstückaufnahme 61 grundplattenseitig, insbesondere in ihrem Peripheriebereich, wiedergelagert. In der dargestellten, bevorzugten Ausführungsform erfolgt diese Widerlagerung mittels einer weiteren umlaufenden, hydraulisch, aber bevorzugt pneumatisch betätigbaren bzw. expandierbaren Dichtung 75, welche über einen oder mehrere Anschlüsse 77 druckmediumbeaufschlagt wird. Wie dargestellt, können sich die umlaufenden Dichtungen 71 und

75, jeweils an Grundplatten- und Abdeckungsstruktur-Innenflächen, gegenüberliegen, können aber auch ggf. versetzt sein, jedenfalls nehmen sie zwischen sich, druckbeaufschlagt, die Werkstückaufnahme 61 dichtend verspannend auf.

5 Die Dichtung 75 schliesst ein verbleibendes Kammervolumen 79 zwischen Unterseite der Werkstückaufnahme 61 und Innenfläche der Grundplatte 45 ab. Dieses Volumen sowie die eigentliche Schleusenkammer zwischen geschlossenem Deckel 65 und peripher gedichteter Oberseite der Werkstückaufnahme 61 wird durch eine
10 Zentrumsöffnung 81 (siehe auch Fig. 9) an der Werkstückaufnahme 61 und einen bezüglich der Öffnungsachse Z_{s1} bevorzugt zentrierten Pumpanschlussstutzen 83 an der Grundplatte 45 abgepumpt. Zur weiteren Reduktion des Schleusenkammervolumens ist der Deckel 65, wie in Fig. 8 ersichtlich, gegen die Werkstückaufnahme 61 hin soweit eingebuchtet, dass seine Innenfläche ein
15 auf der Aufnahme 61 gehaltes Werkstück 85 gerade nicht berührt.

Ist das Werkstück 85, wie beispielsweise bei Speicherscheiben, insbesondere optischen Speicherscheiben, mit einer Zentrumsöffnung versehen, so erfolgt der Durchgriff von Pumpstutzen 83 auf das Schleusenkammervolumen oberhalb des Werkstückes ungehindert durch diese Zentrumsöffnung des Werkstückes hindurch. Ist das scheibenförmige Werkstück ohne Zentrumsöffnung ausgebildet, so können (nicht dargestellt) radiale Verbindungskanäle in der
20 werkstückzugekehrten Oberfläche der Werkstückaufnahme 61 diesen Durchgriff verbessern, beispielsweise ein Netz von radialen Nuten.
25

Die in den Figuren 8 und 9 dargestellte, bevorzugte, höchst kompakte Vakuumbehandlungsanlage verwendet die erfindungsgemäß-

se Transportkammer mit nur gerade zwei Öffnungen 51, nämlich Öffnung 51a und 51b. Während, wie erläutert wurde, an der Öffnung 51a eine kleinstvolumige Schleusenkammer integriert ist, ist an der zweiten Öffnung 51b eine Werkstückbehandlungsstation 5 angeflanscht. In der dargestellten Anlagenrealisationsform, insbesondere für das Sputterbeschichten von kreisscheibenförmigen Werkstücken, insbesondere von Speicherscheiben, dabei insbesondere von optischen Speicherscheiben, ist an der Öffnung 51b die erfundungsgemäße Sputterstation 80 montiert.

10 Die Zentralachse Z_s der Sputterquelle 80 ist dabei von der andern Öffnung 51a weggeneigt, derart, dass am Montageflansch 82 für die geneigt montierte Sputterquelle 80 der Linearantrieb 83 für die Schwenkbewegung des Deckels 65 montiert werden kann.

An der dargestellten Sputteranlage ist an der Werkstückaufnahme 15 61 ein zentraler Teil 84 abhebbar. An der Grundplatte 45 ist ein Hub- und Drehantrieb 86 montiert, ausgerichtet auf die Achse Z_{s1b} . Ist die Werkstückaufnahme 61 in der Öffnung 51b zentriert, so wird mit dem Antrieb 86, wie mit F in Fig. 8 dargestellt, mit dem zentralen Teil 84 das Werkstück 85 in Bearbeitungsposition bezüglich der Sputterquelle 80 hochgehoben und gleichzeitig, wie mit ω dargestellt, in Umdrehung versetzt.

20 Die Sputterquelle 80 ist in bevorzugter Ausführungsform um eine Achse 87 schwenkgelagert montiert, welche Achse 87, bezüglich der Öffnung 51b, der Achse 67 des Deckels 65 gegenüberliegt und diesbezüglich parallel ist. Damit wird erreicht, dass die Sputterquelle 80 ohne Beeinträchtigung des Deckelantriebs 83 am Flansch 82, wie zu Wartungszwecken oder zum Targetersatz, abgeklappt werden kann, wie dies in Fig. 8 mit Ω dargestellt ist.

Mit der erfindungsgemässen Transportkammer und der erfindungsgemässen Vakuumbehandlungsanlage wird eine höchst kompakte Transportweg-optimierte, konstruktiv einfache Anlage bzw. Kammer geschaffen, welche einen hohen Durchsatz ermöglicht, bei

5 Realisation höchst gleichförmiger Beschichtungs-Schichtdicken. Sie eignet sich insbesondere für den Transport bzw. die Behandlung kreisscheibenförmiger Werkstücke, dabei insbesondere für Speicherscheiben, ganz besonders für die Behandlung optischer Speicherscheiben.

10 Mit einer erfindungsgemässen Anlage gemäss den Figuren 8 bzw. 9 wurden, bezüglich der Substratträgerachsen zentriert, Substrate mit Durchmessern von 200 mm resp. 240 mm beschichtet. Dabei galt folgendes:

15 Magnetronquelle: Von der Anmelderin vertriebene ARQ920G-Quelle mit NiV7-Rundtarget.

Targetdurchmesser: 155 mm

Sputterleistung: 500 W bzw. 1 kW

Abgelegte Schichtdicken: 50 bis 100 nm

20 Target/Substrat-Abstand (D): 100 mm bzw. 140 mm

Neigungswinkel β zwischen Zentralachse der Quelle und Substraträgerachse:

45°, 48° bzw. 50°

Argondruck: 2×10^{-3} mbar

25 Anwendung für Master Disks

In Fig. 10 sind die Resultate der erwähnten Beschichtung zusammengestellt. Daraus ist die äusserst gute Gleichförmigkeit der abgelegten Schichtdicke erkenntlich sowie deren Optimierung durch geringfügige Änderung des erwähnten Neigungswinkels β .

Patentansprüche:

1. Sputterkammer mit mindestens einer Sputterquelle, mit zu einer Zentralachse mindestens genähert symmetrischer Sputterneufläche, weiter mit einem Substratträger, der getrieben um 5 eine Substratträgerachse drehbar ist, wobei Zentralachse und Substratträgerachse zueinander schief stehen, dadurch gekennzeichnet, dass die Sputterquelle eine Magnetronsputterquelle ist.

10 2. Kammer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Sputterneufläche bezüglich der Zentralachse im wesentlichen rotationssymmetrisch ist.

15 3. Kammer nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sich Zentralachse und Substratträgerachse mindestens genähert schneiden.

4. Kammer nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass für den Winkel β zwischen Zentralachse und Substratträgerachse gilt:

$$30^\circ \leq \beta \leq 60^\circ,$$

bevorzugt

20 $40^\circ \leq \beta \leq 55^\circ,$

insbesondere bevorzugt

$$43^\circ \leq \beta \leq 50^\circ,$$

insbesondere

$$\beta \approx 45^\circ.$$

5. Kammer nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass Zentralachse und Substratträgerachse mindestens genähert auf einer sputterzubeschichtenden Oberfläche eines auf dem Substratträger aufgebrachten Substrates ihren kleinsten Abstand haben.

6. Kammer nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sie beliebig im Raum lageorientiert werden kann, vorzugsweise, dass der Substratträger mindestens genähert horizontal liegt.

10 7. Kammer nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Projektion der Sputterneufläche auf eine Ebene senkrecht zur Zentralachse grösser ist als die auf dieselbe Ebene projizierte sputterzubeschichtende Fläche mindestens eines auf dem Substratträger aufnehmbaren Substrates.

15 8. Kammer nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei der erwähnten Sputterquellen vorgesehen sind, die gleichzeitig auf ein Substrat zur Wirkung gebracht werden können.

9. Kammer nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Sputterquelle eine zur Zentralachse im wesentlichen rotationssymmetrische Sputterneufläche aufweist und, im Betrieb, in der Sputterfläche mindestens einen um die Zentralachse kreisförmig umlaufenden Erosionsgraben erzeugt, wobei für den Radius r_T des Ortes grösster Erosionstiefe des radial äussersten Erosionsgrabens und für den Abstand D des Ortes geringsten Abstandes von Zentralachse und Substratträgerachse von der Sputterfläche gilt:

$$1/4 \leq r_T / D \leq 2/3.$$

10. Kammer nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Sputterneufläche bezüglich der Zentralachse im wesentlichen rotationssymmetrisch ist und bezüglich des Sputterflächen-Durchmessers ϕ_r und des Abstandes D zwischen der Sputterfläche und dem Ort geringsten Abstandes von Zentralachse und Substratträgerachse - vorzugsweise auf der sputterzubeschichteten Substratfläche - gilt:

$$3/4 \leq \phi_r / D \leq 2,$$

bevorzugt

10 $\phi_r \approx 1,2 D.$

11. Kammer nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Substratträger zur zentrierten Aufnahme eines oder mehrerer Substrate ausgebildet ist und hierzu eine zur Substratträgerachse zentrierte Substrat-Aufnahmefläche aufweist, wobei für den Durchmesser der Aufnahmefläche ϕ_s und für den Abstand D des Ortes geringsten Abstandes von Zentralachse und Substratträgerachse - vorzugsweise auf der zu beschichtenden Substratfläche liegend -, von der Sputterneufläche gilt:

$$\phi_s / D \leq 1,8.$$

20 12. Kammer nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Sputterneufläche bezüglich der Zentralachse rotationssymmetrisch ist und der Substratträger zur zentrierten Aufnahme eines oder mehrerer Substrate ausgebildet ist und hierzu eine zur Substratträgerachse zentrierte Aufnahmefläche aufweist, wobei weiter bezüglich des Durchmessers der Substrataufnahmefläche ϕ_s und des Durchmessers ϕ_r der Sputterneufläche gilt:

$$0,5 < \phi_s / \phi_r \leq 2,4,$$

vorzugsweise

$$1 \leq \phi_s / \phi_r \leq 2,4.$$

13. Kammer nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Substratträger eine zentrierte Aufnahmefläche für mindestens ein Substrat aufweist mit einem Durchmesser ϕ_s , für den gilt:

$$50 \text{ mm} \leq \phi_s \leq 400 \text{ mm},$$

vorzugsweise

10 $50 \text{ mm} \leq \phi_s \leq 300 \text{ mm},$

dass der Durchmesser ϕ_s weiter bevorzugt beträgt:

64 mm oder 120 mm oder 160 mm bis 240 mm.

14. Kammer nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Substratträger in Richtung der Substratträgerachse getrieben linear verschieblich ist.

15. Kammer nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass in Bearbeitungsposition ein auf dem Substratträger angeordnetes Substrat oder der Substratträger selber mit der Sputterfläche einen Prozessraum zweiseitig abgrenzt.

20 16. Vakuumbehandlungsanlage mit mindestens einer Sputterkammer nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Sputterkammer über eine oder mehrere Transportkammern mit mindestens einer Schleusenkammer verbunden ist, worin Substrate

von der Umgebung in Vakuum ein- bzw. von Vakuum in die Umgebung ausgeschleust werden.

17. Vakuumtransportkammer für scheibenförmige Substrate, gekennzeichnet durch

5 • eine Grundplattenstruktur (45), die mit ihrer Innenfläche den
Innenraum (3) der Kammer einseitig berandet;

10 • eine der Innenfläche der Grundplattenstruktur im wesentlichen
parallel gegenüberliegende Abdeckungsstruktur mit mindestens
zwei der Substratscheibenfläche angepassten Substratdurchrei-
cheöffnungen;

15 • eine um eine Drehachse, senkrecht zur Grundplattenstruktur,
getrieben drehbewegliche Transporteinrichtung in der Kammer
mit mindestens einer Substrataufnahme, welche durch die Dreh-
bewegung in Ausrichtung jeweils mit einer der Öffnungen
15 bringbar ist,

wobei eine gesteuerte Dichtungsanordnung die Umrandung minde-
stens einer der Öffnungen mit der mit ihr in Ausrichtung ge-
brachten Substrathalterung bzw. einem darauf vorgesehenen
Substrat erstellt.

20 18. Transportkammer nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet,
dass die eine der Öffnungen mit einem vorzugsweise motorisch
schliessbaren Deckel gegen die Umgebung ausgerüstet ist, wobei
Deckel und in Ausrichtung mit dieser Öffnung gebrachte Werk-
stückaufnahme bzw. ein Werkstück an dieser Aufnahme innen- bzw.
25 aussenseitige Schleusenventile für eine an dieser Öffnung inte-
grierte Schleusenkammer bilden.

19. Kammer nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel gegen die Kammer eingebuchtet ist zur Reduktion des abzupumpenden Schleusenvolumens.

20. Kammer nach einem der Ansprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungsanordnung mindestens eine um eine Öffnung kammerinnenseitig umlaufende, pneumatisch oder hydraulisch betätigbare Dichtung aufweist.

21. Kammer nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungsanordnung eine um die mit dem Deckel versehene Öffnung kammerseitig umlaufende, pneumatisch oder hydraulisch betätigbare Dichtung aufweist, und dieser Dichtung eine an der Grundplattenstruktur-Innenfläche gegenüberliegende, umlaufende, vorzugsweise pneumatisch oder hydraulisch betätigbare weitere Dichtungsanordnung vorgesehen ist, welche beide Dichtungsanordnungen die auf diese Öffnung ausgerichtete Werkstückaufnahme dichtend zwischen sich aufnehmen.

22. Kammer nach einem der Ansprüche 17 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Werkstückaufnahme mindestens eine Öffnung, vorzugsweise eine zentrale Öffnung, aufweist.

23. Kammer nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel so weit eingebuchtet ist, dass, geschlossen, seine Innenfläche eine Werkstückscheibe auf der mit besagter Öffnung ausgerichteten Werkstückaufnahme gerade nicht berührt.

24. Transportkammer nach einem der Ansprüche 17 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass zwei der genannten Öffnungen vorgesehen sind, die Drehachse der Transporteinrichtung bezüglich einer Verbindungsleitung der Öffnungszentren versetzt angebracht ist, und die Werkstückaufnahme von Ausrichtung mit einer der

Öffnungen zu Ausrichtung mit der anderen der Öffnungen eine Schwenkbewegung um die Drehachse von höchstens 120°, vorzugsweise von höchstens 90°, durchführt.

25. Transportkammer nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet,
5 dass die Öffnungen an der Abdeckungsstruktur im wesentlichen nur soviel getrennt sind, dass dazwischen das Anflanschen einer Vakuumbehandlungskammer möglich ist.

26. Transportkammer nach einem der Ansprüche 24 oder 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehachse der Transporteinrich-
10 tung seitlich an die Grundplattenstruktur angeflanscht ist.

27. Transportkammer nach einem der Ansprüche 17 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass an mindestens einer der Öffnungen, der Abdeckungsstruktur gegenüberliegend und vorzugsweise bezüglich der Öffnung zentriert, an der Grundplattenstruktur ein
15 Werkstückhubantrieb angebracht ist und/oder ein Werkstückdrehantrieb.

28. Transportkammer nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dass die Werkstückaufnahme einen zentralen Teil aufweist, der vom übrigen mit der Drehachse verbundenen Transporteinrich-
20 tungsteil, senkrecht zur Grundplattenstruktur-Innenfläche, abhebbar ist, mit welchem der Hub und/oder Drehantrieb dann gesteuert in Wirkverbindung gebracht wird, wenn die Werkstückaufnahme mit der einen Öffnung ausgerichtet ist, die den erwähnten Antrieb aufweist.

25 29. Vakuumbehandlungsanlage mit einer Vakuumtransportkammer nach einem der Ansprüche 17 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass an mindestens einer der Öffnungen an der Abdeckungsstruktur

tur der Vakuumtransportkammer eine Vakuumbehandlungsstation angeflanscht ist.

30. Anlage nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, dass die Station eine Sputterquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 15 ist.

31. Anlage nach Anspruch 30 mit der Vakuumtransportkammer nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass an der Transportkammer zwei der Öffnungen vorgesehen sind und die Zentralachse der Sputterquelle an einer der beiden Öffnungen von der andern Öffnung weggeneigt ist, und dass vorzugsweise ein motorischer Antrieb für einen Deckel an der andern Öffnung an einem Anschlussflansch für die Quelle angeordnet ist.

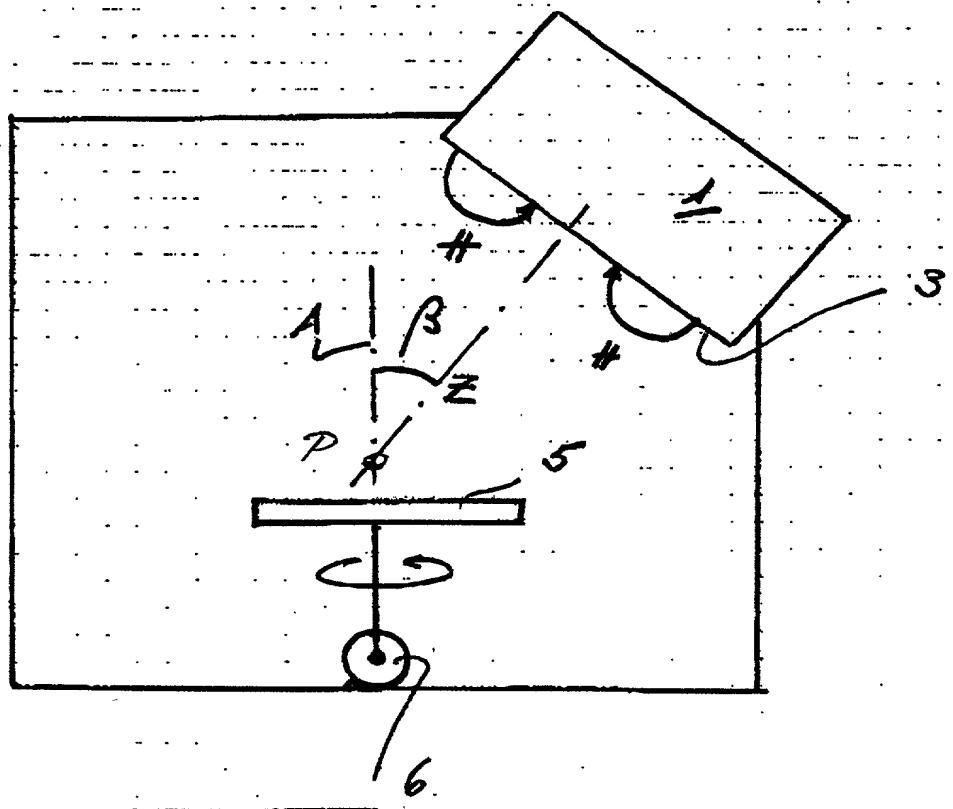
32. Anlage nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel an einem Schwenklager mit bezüglich der Abdeckungsstruktur paralleler Schwenkachse schwenkgelagert ist, welche zwischen den Öffnungen angeordnet ist und vorzugsweise die Quelle ebenfalls schwenkgelagert ist um eine zur Abdeckungsstruktur parallele Schwenkachse, welche, bezüglich der mit der Quelle versehenen Öffnung, der Schwenkachse des Deckels gegenüberliegt.

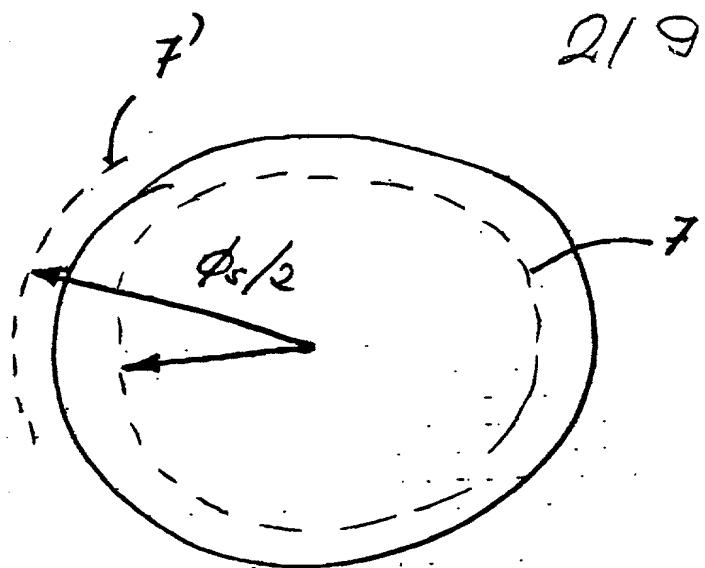
33. Verfahren zur Herstellung beschichteter Datenspeicherscheiben oder Wafer, dadurch gekennzeichnet, dass man mindestens einen Beschichtungsschritt durch schiefwinkeliges Magnetronspattern auf das rotierende Substrat ausführt.

25 34. Verwendung der Sputterkammer nach einem der Ansprüche 1 bis 15, der Transportkammer nach einem der Ansprüche 17 bis 28, der Anlage nach einem der Ansprüche 16 bzw. 29 bis 32 bzw. des Verfahrens nach Anspruch 33 für die Beschichtung optischer Da-

tenspeicher-Substrate, von Master oder von piezoelektrischen Wafern oder von Wafern für die Halbleiterfertigung.

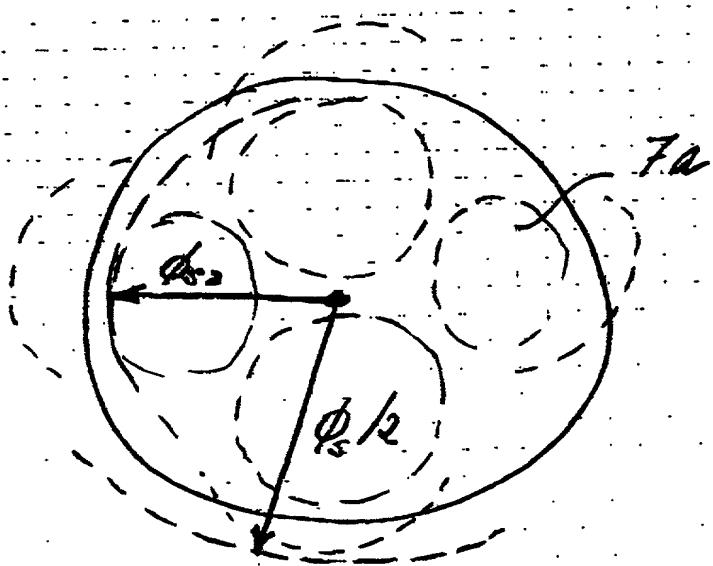
119





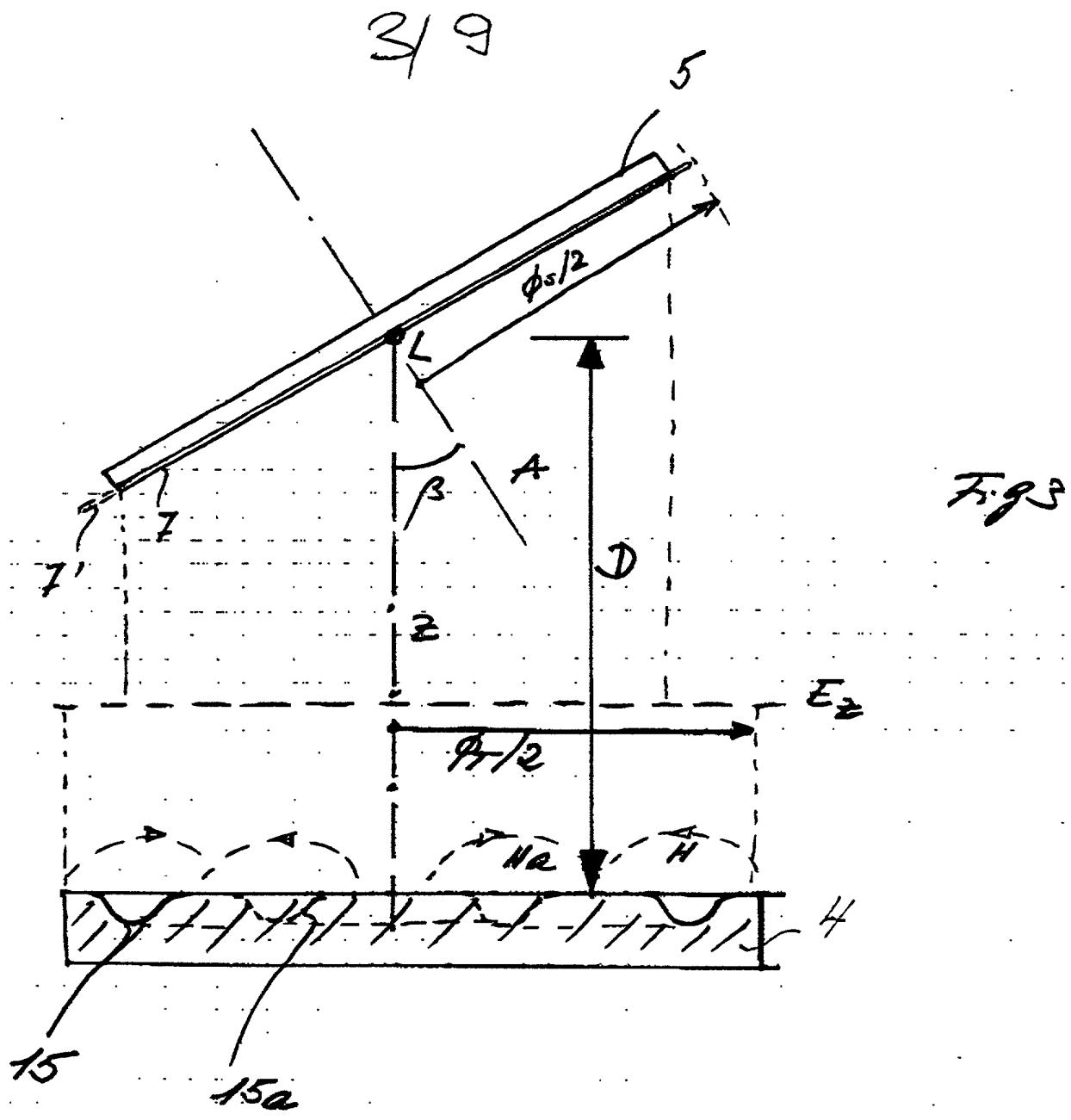
219

F32a

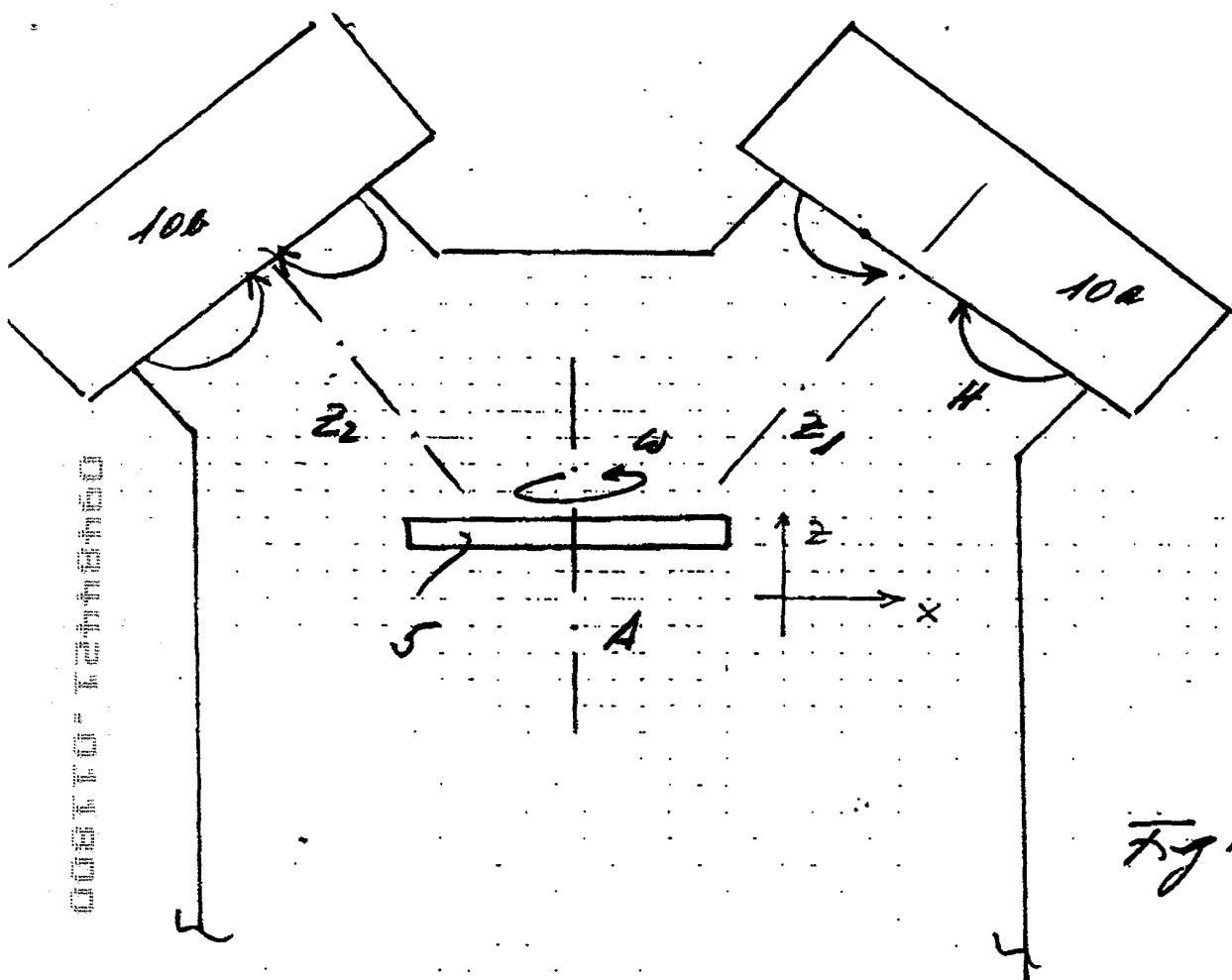


72

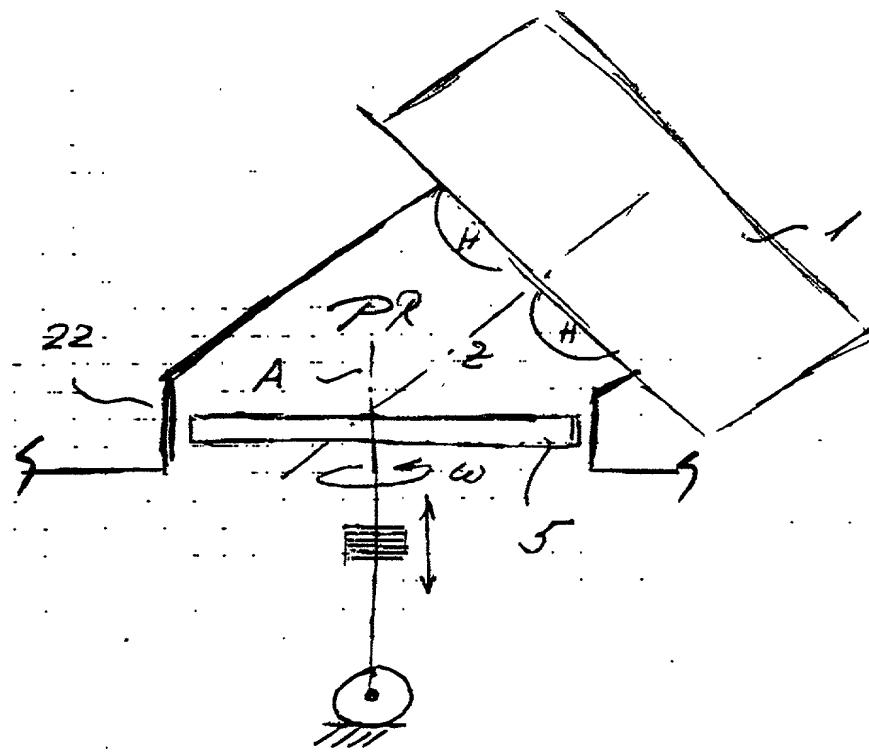
F32c



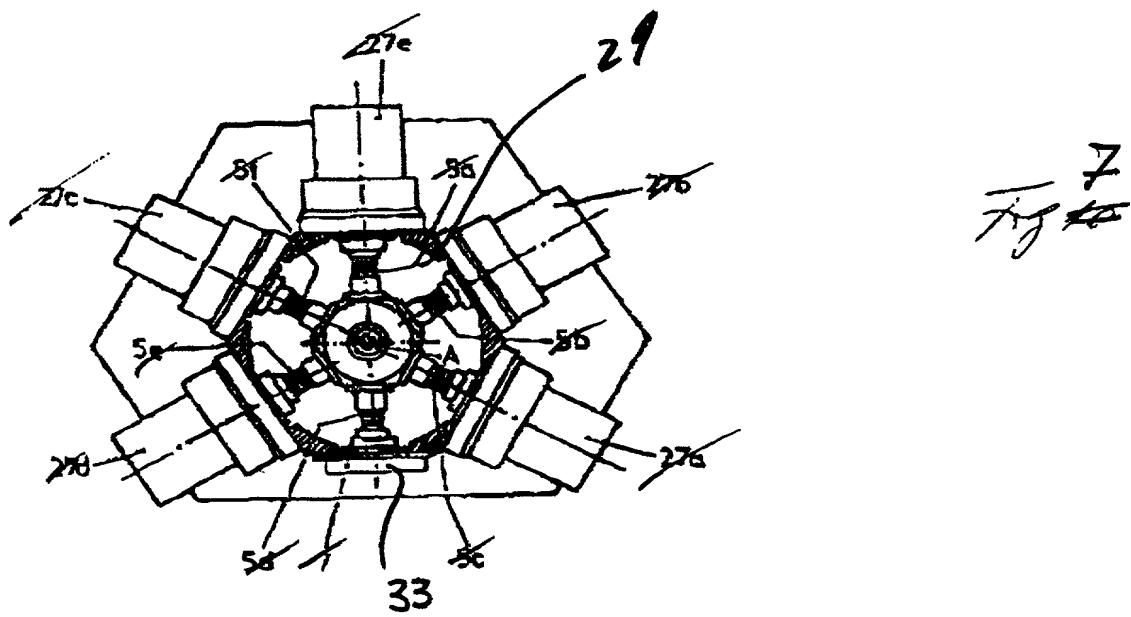
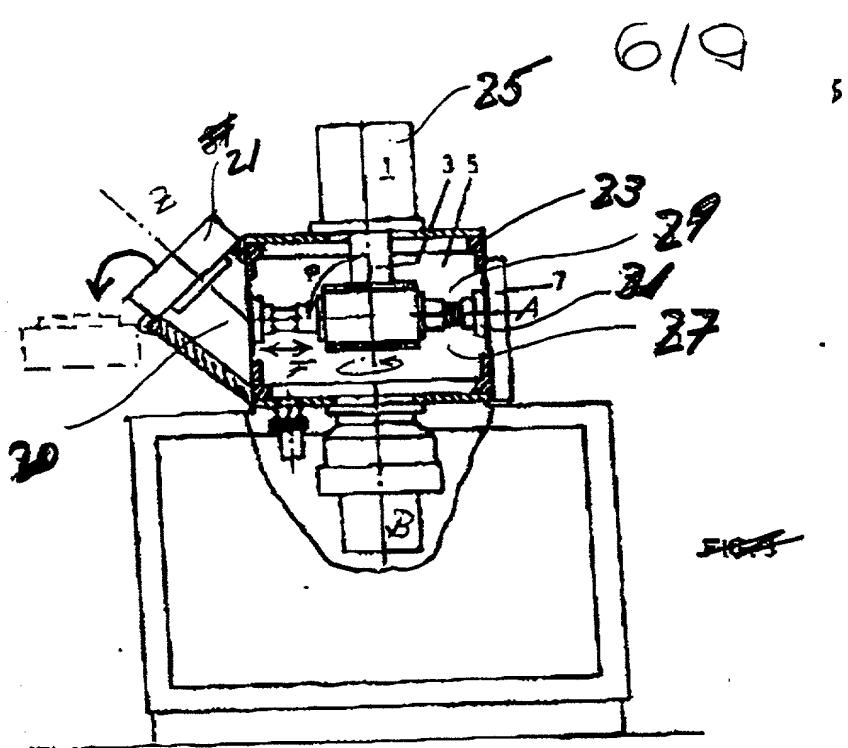
419

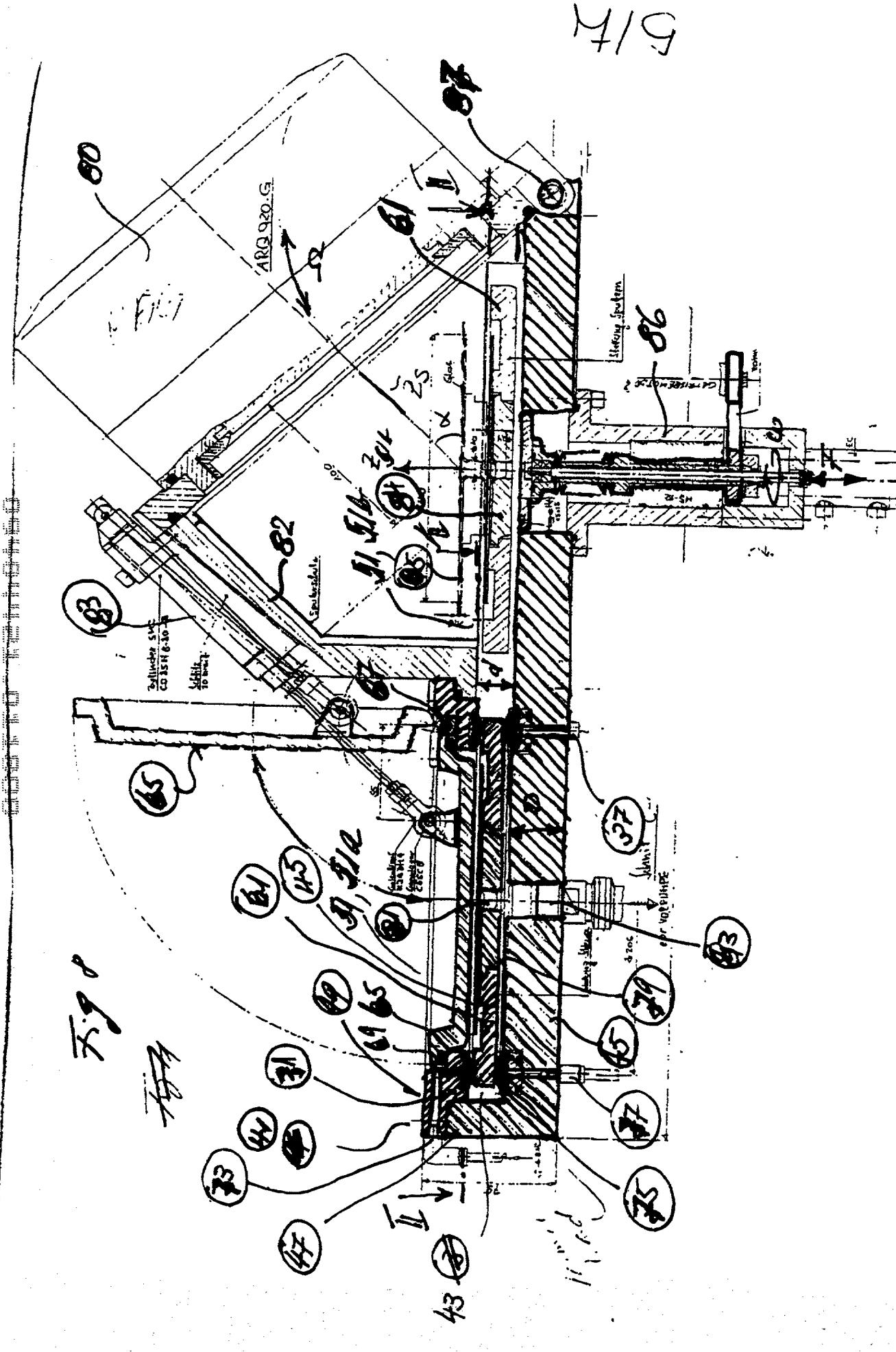


519



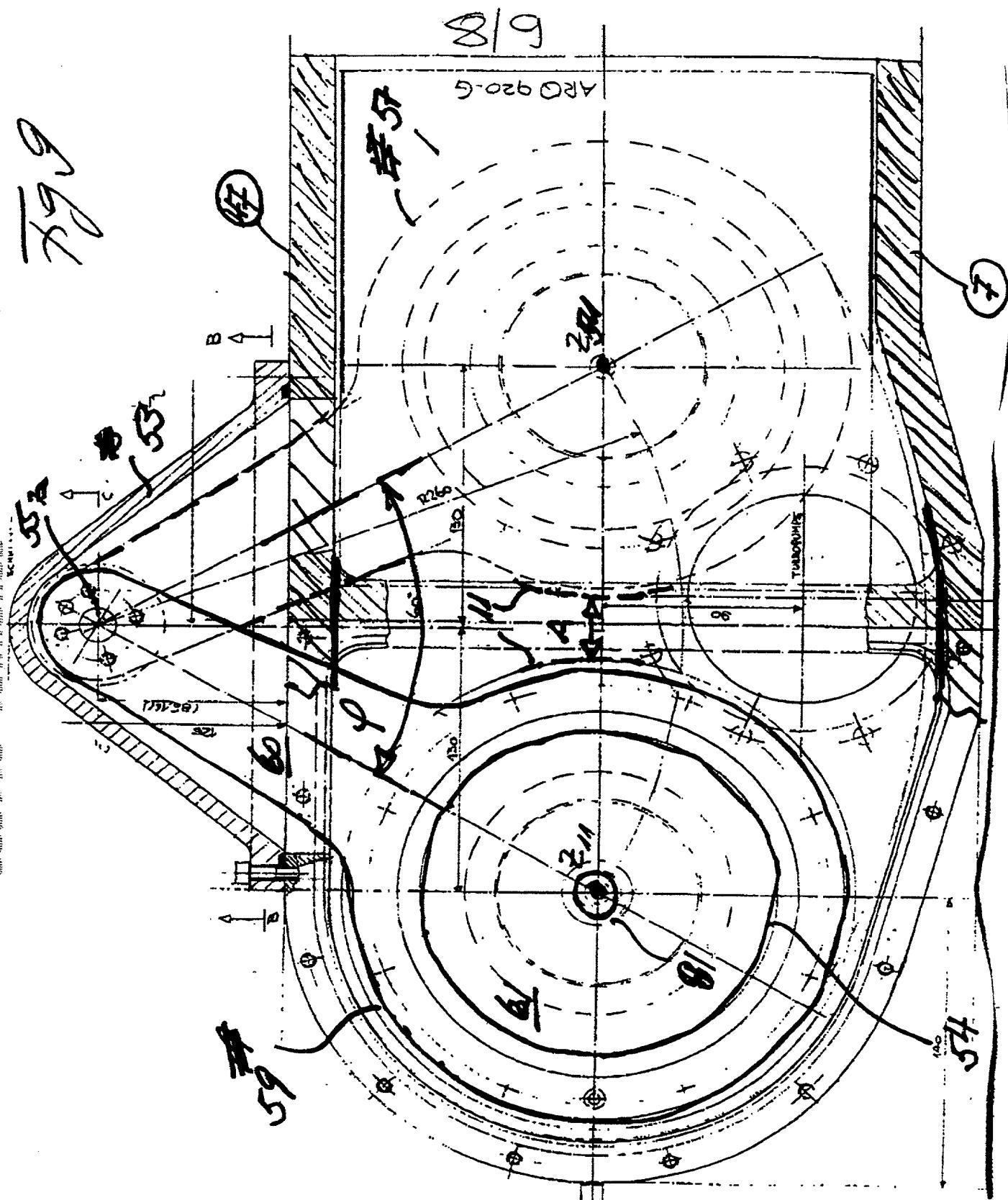
519





卷之三

19
19



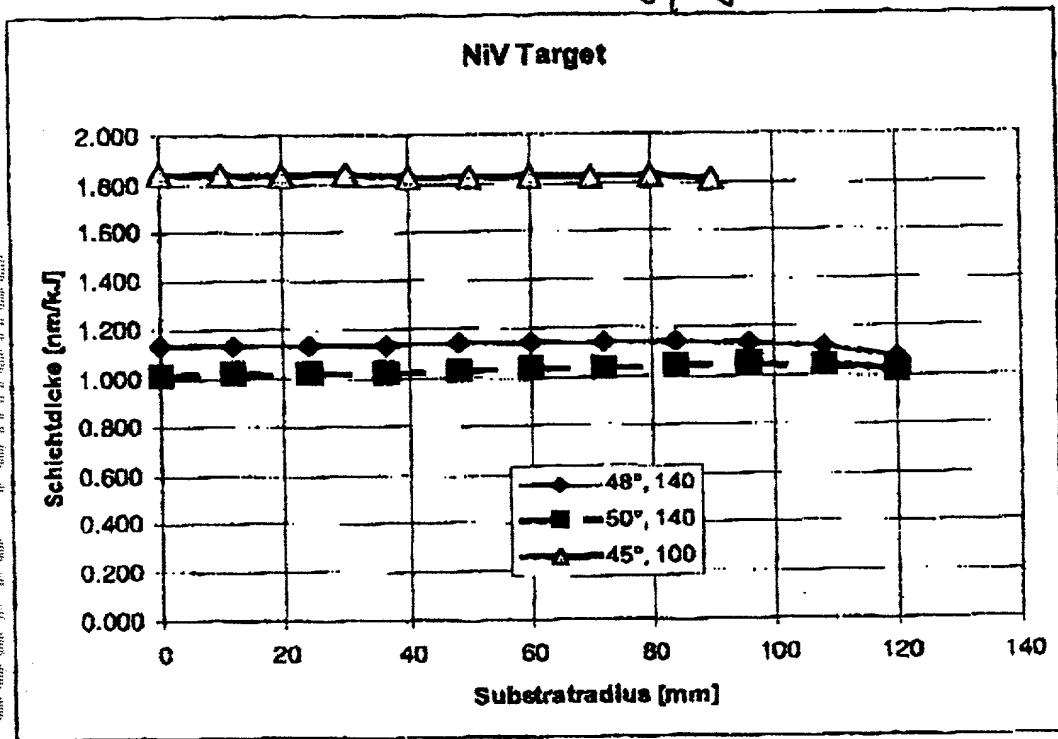


Fig 10

DECLARATION AND POWER OF ATTORNEY - PATENT APPLICATION

As a below named inventor, I hereby declare that my citizenship, postal address and residence are as stated below; that I verily believe I am the original, first and sole inventor (if only one inventor is named below) or a joint inventor (if plural inventors are named below) of the invention entitled:

**SPUTTER CHAMBER AS WELL AS VACUUM TRANSPORT CHAMBER AND
VACUUM HANDLING APPARATUS WITH SUCH CHAMBERS**

the specification of which

X is attached hereto, or
 was filed on _____ as Application Serial No. _____ and
 was amended on _____ (if applicable).

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above-identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above. I acknowledge the duty to disclose all information known to be material to patentability as defined in 37 CFR §1.56. I hereby claim foreign priority benefits under Title 35, United States Code §119 of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate listed below and have also identified below any foreign application for patent or inventor's certificate having a filing date before that of the application on which priority is claimed:

Prior Foreign Application(s)

Priority Claimed

<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
<u> </u> (Number)	<u> </u> (Country)	<u> </u> (Day/Month/Year)

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, §120 of any United States application(s) listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, §112, I acknowledge the duty to disclose all information known to be material to patentability as defined in 37 CFR §1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of this application:

<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
<u> </u> (Application Serial No.)	<u> </u> (Filing Date)	<u> </u> (Status)

I hereby appoint as principal attorneys Martin Fleit, Reg. No. 16,900; Herbert I. Cantor, Reg. No. 24,392; James F. McKeown, Reg. No. 25,406; Donald D. Evenson, Reg. No. 26,160; Joseph D. Evans, Reg. No. 26,269; Gary R. Edwards, Reg. No. 31,824; Jeffrey D. Sanok, Reg. No. 32,169; and Richard R. Diefendorf, Reg. No. 32,390, to prosecute and transact all business in the Patent and Trademark Office connected with this application and any related United States and international applications. Please direct all communications to:

Evenson, McKeown, Edwards & Lenahan, P.L.L.C.
1200 G Street, N.W., Suite 700
Washington, D.C. 20005
Telephone: (202) 628-8800
Faxsimile: (202) 628-8844

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under §1001 of Title 18 of the United States Code, and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issuing thereon.

INVENTOR:	Martin Dubs
Citizenship:	Swiss
Post Office Address/	Im unteren Stieg
	CH-7304 Maienfeld
Residence:	Switzerland

 (date)

 (signature of 1st inventor)

DECLARATION AND POWER OF ATTORNEY

Attorney Docket No. 622/48561

Page 2

INVENTOR: **Roman Schertler**

Citizenship: **Austrian**

Post Office Address/
**Lorenz Schertlerstrasse
A-6922 Wolfurt**

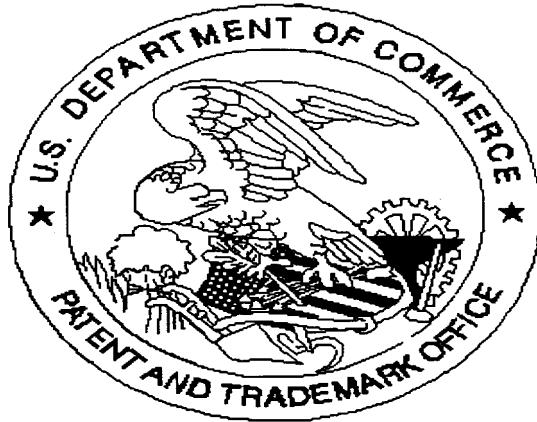
Residence: **Austria**

(date)

(signature of 2nd inventor)

DRAFTED & PREPARED FOR YOU

United States Patent & Trademark Office
Office of Initial Patent Examination -- Scanning Division



Application deficiencies were found during scanning:

Page(s) 7 of Specifications were not present
for scanning. (Document title)

Page(s) _____ of _____ were not present
for scanning. (Document title)

Scanned copy is best available.